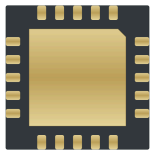
8000–12000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%

LCI-LIM-8000-12000-PIP42U · 8000–12000 MHz · GaAs 封装射频限幅器.

RF 电气表参数: 插入损耗 0.9 dB (典型值); 限幅电平 14 dBm (典型值); 输入耐受功率 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%. RF 测试条件: TA = +25 °C.



QFN20 4 × 4 mm

RF输出端内置隔直电容。

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout: 13

GND: 2, 4, 12, 14

NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

封装外形尺寸: 4 × 4 × 0.75 mm.

RF 特性

TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	f	8000	-	12000	-	MHz
插入损耗	IL	-	0.9	-	-	dB
限幅电平	PLim	-	14	-	-	dBm
输入耐受功率	Pp	-	-	-	42 (PW = 4 ms; D = 20%)	dBm

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大脉冲输入功率 [1]	-	-	-	42	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	125	°C

[1] PW = 4 ms; D = 20%

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	4 × 4 × 0.75	mm

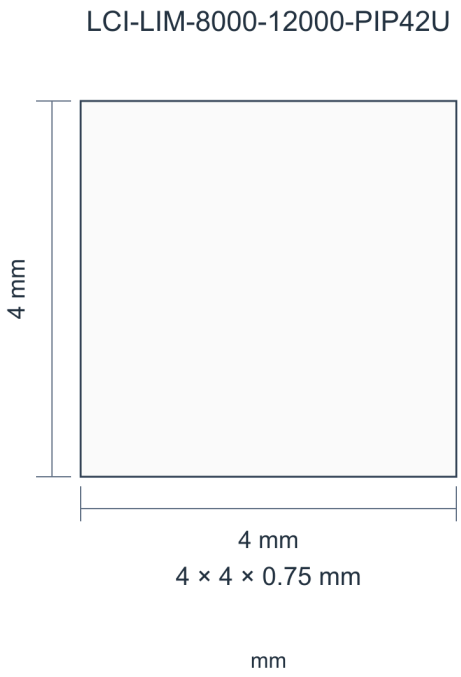
当前出版记录 · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

集成说明

QFN20 4 × 4 mm RF输出端内置隔直电容。 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout: 13 GND: 2, 4, 12, 14 NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

机械外形尺寸图

安装尺寸参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸，安装时请参照完整安装图。



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。